

Si-npn-Leistungstransistor für elektronische Vorschaltgeräte für Gasentladungslampen

Bauform 5 TO3

Wärmewiderstand $R_{thjc} \leq 2,0 \text{ K/W}$

Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

Kollektor-Basis-Spannung $I_E = 0$	U_{CBO}	1 200 V
Kollektor-Emitter-Spannung $I_B = 0$	U_{CEO}	400 V
Kollektorstrom	I_C	4 A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	6 A
Gesamtverlustleistung $\vartheta_c \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	50 W
Betriebstemperatur	ϑ_a	-25 ... +125 $^\circ\text{C}$
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	-25 ... +150 $^\circ\text{C}$

Kennwerte ($\vartheta_c = 25 \text{ }^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

	min	typ	max
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = 1\ 200 \text{ V}, U_{BE} = -2 \text{ V}$			1,0 mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2,5 \text{ A}, I_B = 0,5 \text{ A}$			5,0 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2,5 \text{ A}, I_B = 0,5 \text{ A}$			1,5 V
Kollektor-Basis-Stromverhältnis $U_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 0,5 \text{ A}$	15		
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 100 \text{ mA}$	400		V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung $I_E = 10 \text{ mA}$	6,0		V
Abfallzeit des Kollektorstromes $I_C = 2,5 \text{ A}, I_B = 0,5 \text{ A},$ $- I_B = 1,0 \text{ A}$			1,0 μs